

技術詞彙

本詞彙表載有本文件所用若干技術詞彙的說明。因此，該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「AC」	指	交流電，一種週期性地反轉方向並隨時間連續改變其大小的電流，而與之相對的直流電僅單向流動
「BJT」	指	雙極性結型晶體管，一種場效應晶體管
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「DC」	指	直流電，電荷的單向流動
「無晶圓廠」	指	設計和銷售硬件設備和半導體芯片，同時將其製造服務外包予稱為半導體代工廠的專業製造商
「FET」	指	場效應晶體管，一種通過半導體用電子場控制電流的晶體管
「代工廠」	指	生產金屬鑄件的加工廠
「氮化鎵」	指	氮化鎵，一種二元III/V族直接的寬帶隙半導體，用於各種電子應用
「HPC」	指	高性能計算，指使用強大的計算系統高速處理大量數據，通常涉及併行處理、GPU等高級處理器及高帶寬網絡。
「IDM」	指	集成器件製造商，一家涵蓋從芯片設計、晶圓製造、封裝測試到產品銷售的垂直整合型公司。
「IGBT」	指	絕緣柵雙極晶體管，一種主要用作電子開關的功率半導體器件
「集成電路」或「IC」	指	所有電路元件集成到單一半導體芯片上的電子電路
「ISO」	指	國際標準化組織，為國家級標準體系的國際聯邦組織
「ISO 14001」	指	ISO發佈的環境管理體系

技術詞彙

「ISO 45001」	指	ISO發佈的職業健康與安全管理體系
「ISO 9001」	指	ISO發佈的國際質量管理體系
「LED」	指	發光二極管，一種半導體二極管，當施加電壓時會發光
「MOSFET」	指	金屬氧化半導體場效應晶體管，一種主要用於放大或轉換電子信號的晶體管
「OSAT」	指	外包半導體封裝與測試，指為半導體芯片提供第三方封裝及測試服務的公司
「功率器件」	指	執行控制電力相關特定功能的獨立電子元件
「RDS(on)值」	指	RDS(on)，指MOSFET的導通電阻，以歐姆(Ω)或毫姆($m\Omega$)為單位，表示MOSFET在導通狀態下漏極與源極之間的電阻
「RoHS及REACH指令」	指	《危害物質限用指令》和《化學品註冊、評估、許可和限制》，歐盟製定的法規
「碳化硅」	指	碳化硅，一種用於各種電子應用的寬帶隙半導體
「晶體管」	指	除放大和產生該等電信號之外，還調節或控制電流或電壓流動的半導體器件，為功率器件的子類
「VCE(sat)」	指	雙極結型電晶體(BJT)或絕緣柵雙極電晶體(IGBT)的集電極-發射極飽和電壓，其被定義為晶體管處於完全導電的「飽和」狀態時集電極與發射極之間的電勢差，通常是在集電極電流和基極電流(對於BJT)或柵極電壓(對於IGBT)的特定條件下
「晶圓」	指	一種半導體材料的薄片(例如硅晶體)，大量集成電路或分立器件在製造過程中在其上被組裝